

高温 CVD 装置

SiC 用 CVD 装置 (HTC3001)



※本装置は NEDO が委託している
新機構素子研究開発協会先進パワーデバイス研究所殿に納入しました。

- リアクタ：縦型石英製
フェイスダウン
- 投入室：トランスファーロード付
- 基板サイズ：φ3 インチ×1 枚
- 基板加熱：高周波加熱方式
- 最高加熱温度：1800℃(放射温度計値)
- 適用：SiC など

オール・イン・ワン CVD 装置



奈良先端科学技術大学院大学殿納入設備

- リアクタ：横型石英製
- 基板サイズ：φ2 インチ×1 枚
- 基板加熱：高周波加熱方式
- 最高加熱温度：1500℃(放射温度計値)
- フットプリント：1.3m×1.3m
- 適用：Si, SiC など

高温 CVD 装置 (SH2001-HTA)

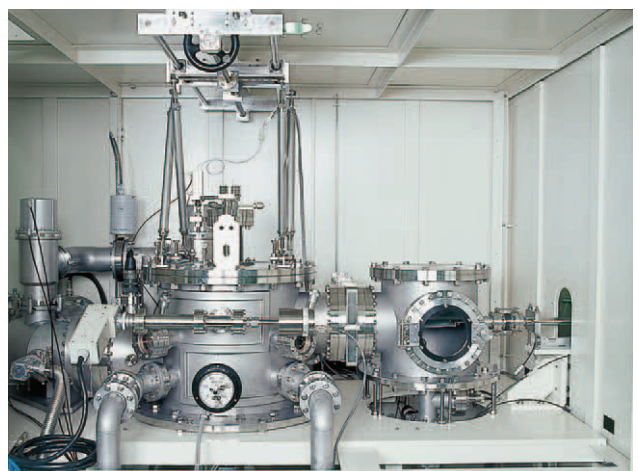


名城大学殿納入設備

- リアクタ：横型ステンレス製
フェイスダウン
- 基板サイズ：φ1 インチ×1 枚
- 基板加熱：抵抗加熱方式
- 最高加熱温度：1800℃(制御用熱電対値)
- 適用：AlN など

特許取得済

高温 CVD 装置・酸化装置 (OV4001)



- リアクタ：縦型ステンレス製
- 基板サイズ：φ4 インチ×1 枚
- 基板加熱：抵抗加熱方式
- 最高加熱温度：1400℃(制御用熱電対値)
- 適用：SiC 酸化プロセスなど

特許取得済